

AMC0381D 是一款精密的高压直流输入 增强型隔离放大器，具有固定增益差分输出

1 特性

- 集成高压电阻分压器，无需外部电阻器即可直接进行直流检测
- 差分输出
- 电源电压范围：
 - 高侧 (VDD1)：3.0V 至 5.5V
 - 低侧 (VDD2)：3.0V 至 5.5V
- 低直流误差：
 - 失调电压误差：±0.8mV (最大值)
 - 温漂：±10μV/°C (最大值)
 - 衰减误差：±0.25% (最大值)
 - 衰减漂移：±40ppm/°C (最大值)
 - 非线性度：0.025% (最大值)
- 高 CMTI：150V/ns (最小值)
- 低 EMI：符合 CISPR-11 和 CISPR-25 的限值要求
- 可用的输入选项：
 - AMC0381D06：600V，10MΩ
 - AMC0381D10：1000V，12.5MΩ
 - AMC0381D16：1600V，33.5MΩ
- 安全相关认证：
 - 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 7000V_{PK} 增强型隔离
 - 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000V_{RMS} 隔离
- 可在更大的工业级温度范围内正常工作：-40°C 至 +125°C

2 应用

- 服务器电源单元 (PSU)
- 能量存储系统 (ESS)
- 光伏逆变器
- 电动汽车充电站

3 说明

AMC0381D 是一款精密的电隔离放大器，具有 高压直流、高阻抗输入和固定增益差分输出。输入专为直接连接到高压信号源而设计。

隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件隔开。该隔离栅抗电磁干扰性能极强，并经过认证，可提供高达 5kV_{RMS} 的增强型隔离 (60s)。

AMC0381D 输出与输入电压成正比的差分信号。差分输出对接地漂移不敏感，这使得可以将输出信号进行远距离传输。

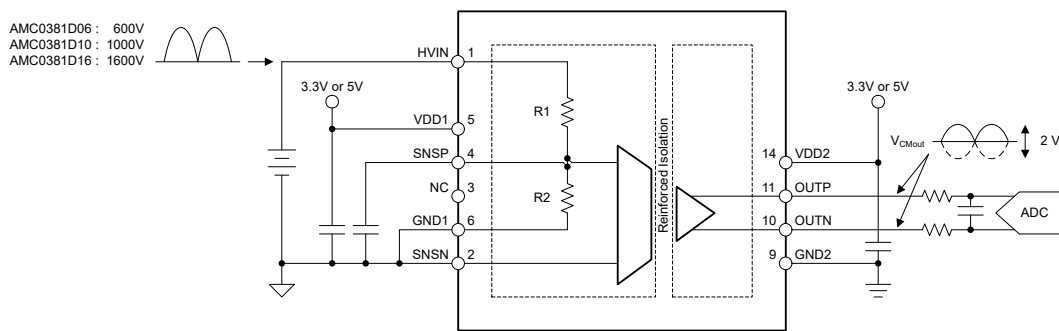
AMC0381D 提供三个线性输入电压范围：600V、1000V 和 1600V。借助集成式精密电阻分压器，AMC0381D 在整个温度范围和使用寿命内实现低于 1% 的精度。

AMC0381D 采用 15 引脚 0.65mm 间距 SSOP 封装。该器件的完全额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。

封装信息

器件型号	封装 ⁽¹⁾	封装尺寸 ⁽²⁾
AMC0381D	DFX (SSOP, 15)	12.8mm × 10.3mm

- (1) 有关更多信息，请参阅 [机械、封装和可订购信息](#)。
 (2) 封装尺寸 (长 × 宽) 为标称值，并包括引脚 (如适用)。



典型应用



内容

1 特性	1	7.1 概述	18
2 应用	1	7.2 功能方框图	18
3 说明	1	7.3 特性说明	18
4 器件比较表	3	7.4 器件功能模式	21
5 引脚配置和功能	4	8 应用和实施	22
6 规格	5	8.1 应用信息	22
6.1 绝对最大额定值.....	5	8.2 典型应用	22
6.2 ESD 等级.....	5	8.3 最佳设计实践	24
6.3 建议运行条件.....	5	8.4 电源相关建议	25
6.4 热性能信息.....	7	8.5 布局	26
6.5 额定功率.....	7	9 器件和文档支持	27
6.6 绝缘规格.....	8	9.1 文档支持.....	27
6.7 安全相关认证.....	9	9.2 接收文档更新通知.....	27
6.8 安全限值.....	9	9.3 支持资源.....	27
6.9 电气特性.....	10	9.4 商标.....	27
6.10 开关特性.....	11	9.5 静电放电警告.....	27
6.11 时序图.....	12	9.6 术语表.....	27
6.12 绝缘特性曲线.....	13	10 修订历史记录	27
6.13 典型特性.....	14	11 机械、封装和可订购信息	28
7 详细说明	18		

4 器件比较表

表 4-1. 器件比较

器件	R1 ⁽¹⁾	R2 ⁽¹⁾	分压器 分压比	线性输入 范围	削波 电压	绝对最大 输入电压
AMC0381D06	10M Ω	16.7k Ω	601:1	600V	769V	900V
AMC0381D10	12.5M Ω	12.5k Ω	1001:1	1000V	1281V	1500V
AMC0381D16	33.5M Ω	21k Ω	1601:1	1600V	2049V	2000V

(1) R1 和 R2 是近似的电阻值，不能准确反映分压器分压比。

5 引脚配置和功能

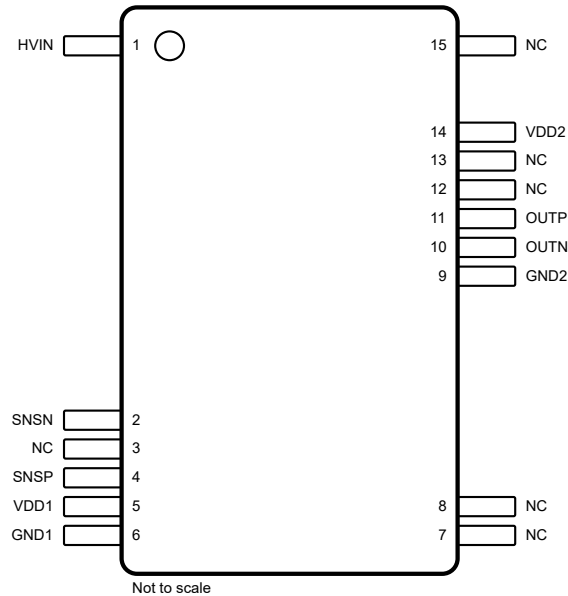


图 5-1. DFX 封装，15 引脚 SOIC（顶视图）

表 5-1. 引脚功能

引脚		类型	说明
编号	名称		
1	HVIN	模拟输入	高压输入
2	SNSN	模拟输入	放大器的接地传感引脚和反相模拟输入。连接至 GND1。
3、7、8、12、13、15	NC	不适用	无内部连接。该引脚可连接至任何电势或保持悬空。
4	SNSP	模拟输入	放大器的电压检测引脚和非反向模拟输入。连接到外部滤波电容器或保持悬空。
5	VDD1	高侧电源	模拟（高侧）电源 ⁽¹⁾
6	GND1	高侧接地端	高侧接地端
9	GND2	低侧接地端	低侧接地端
10	OUTN	模拟输出	反相模拟输出
11	OUTP	模拟输入	同相模拟输出
14	VDD2	低侧电源	低侧电源 ⁽¹⁾

(1) 有关电源去耦方面的建议，请参阅 [电源相关建议](#) 部分。

6 规格

6.1 绝对最大额定值

请参阅⁽¹⁾

		最小值	最大值	单位
电源电压	高侧 VDD1 至 GND1	-0.3	6.5	V
	低侧 VDD2 至 GND2	-0.3	6.5	
模拟输入电压	HVIN 至 GND1, AMC0381D06	-150	900	V
	HVIN 至 GND1, AMC0381D10	-150	1500	
	HVIN 至 GND1, AMC0381D16	-150	2000	
	SNSP、SNSN	GND1 - 0.5	VDD1 + 0.5	
模拟输出电压	OUTP、OUTN	GND2 - 0.5	VDD2 + 0.5	V
输入电流	连续, 除电源和 HVIN 引脚外的任何引脚	-10	10	mA
温度	结温, T _J		150	°C
	贮存温度, T _{stg}	-65	150	

(1) 超出绝对最大额定值范围操作可能会导致器件永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议的工作条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出建议运行条件但在绝对最大额定值范围内使用, 器件可能不会完全正常运行, 这可能影响器件的可靠性、功能和性能, 并缩短器件寿命

6.2 ESD 等级

			值	单位
V _(ESD)	静电放电	人体放电模型 (HBM), 符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准 ⁽¹⁾	±2000	V
		充电器件模型 (CDM), 符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 标准 ⁽²⁾	±1000	

(1) JEDEC 文档 JEP155 指出: 500V HBM 可通过标准 ESD 控制流程实现安全生产。

(2) JEDEC 文档 JEP157 指出: 250V CDM 能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。

6.3 建议运行条件

在工作环境温度范围内测得 (除非另有说明)

			最小值	标称值	最大值	单位
电源						
VDD1	高侧电源	VDD1 至 GND1	3	5.0	5.5	V
VDD2	低侧电源	VDD2 至 GND2	3	3.3	5.5	V
模拟输入						
V _{Clipping}	削波输出前的标称输入电压	以 SNSP 为基准	-0.1		1.28	V
		以 HVIN 为基准, AMC0381D06	-60		769	
		以 HVIN 为基准, AMC0381D10	-100		1281	
		以 HVIN 为基准, AMC0381D16	-160		2049	
V _{FSR}	额定线性输入电压	以 SNSP 为基准	-0.05		1	V
		以 HVIN 为基准, AMC0381D06	-30		600	
		以 HVIN 为基准, AMC0381D10	-50		1000	
		以 HVIN 为基准, AMC0381D16	-80		1600	
模拟输出						
C _{LOAD}	容性负载	OUTP 或 OUTN 至 GND2 ⁽¹⁾			500	pF
		OUTP 至 OUTN ⁽²⁾			250	
R _{LOAD}	电阻负载	OUTP 或 OUTN 至 GND2		10	1	kΩ

在工作环境温度范围内测得（除非另有说明）

		最小值	标称值	最大值	单位
温度范围					
T _A	额定环境温度	-40		125	°C

- (1) 除了从 OUTP 到 OUTN 的差分容性负载外，请勿再添加。
- (2) 除了从 OUTP/OUTN 到 GND2 的单端容性负载外，请勿再添加

6.4 热性能信息

热指标 ⁽¹⁾		DFX (SSOP)	单位
		15 引脚	
$R_{\theta JA}$	结至环境热阻	86.9	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	结至外壳 (顶部) 热阻	36.7	°C/W
$R_{\theta JB}$	结至电路板热阻	43.5	°C/W
Ψ_{JT}	结至顶部特征参数	17	°C/W
Ψ_{JB}	结至电路板特征参数	41.8	°C/W
$R_{\theta JC(bot)}$	结至外壳 (底部) 热阻	不适用	°C/W

(1) 有关新旧热指标的更多信息，请参阅[半导体和 IC 封装热指标](#)应用手册。

6.5 额定功率

参数	测试条件	值	单位
P_D	最大功耗 (两侧)	AVDD = DVDD = 5.5V, $V_{HVIN} = V_{Clipping}$ AMC0381D06	mW
		AVDD = DVDD = 5.5V, $V_{HVIN} = V_{Clipping}$ AMC0381D10	
		AVDD = DVDD = 5.5V, $V_{HVIN} = V_{Clipping}$ AMC0381D16	
P_{D1}	最大功耗 (高侧)	AVDD = 5.5V, $V_{HVIN} = V_{Clipping}$ AMC0381D06	mW
		AVDD = 5.5V, $V_{HVIN} = V_{Clipping}$ AMC0381D10	
		AVDD = 5.5V, $V_{HVIN} = V_{Clipping}$ AMC0381D16	
P_{D2}	最大功耗 (低侧)	DVDD = 5.5V	mW

6.6 绝缘规格

在工作环境温度范围内测得（除非另有说明）

参数		测试条件	值	单位
通用				
CLR	外部间隙 ⁽¹⁾	引脚间的最短空间距离	≥ 8	mm
CPG	外部爬电距离 ⁽¹⁾	引脚间的最短封装表面距离	≥ 9.7	mm
DTI	绝缘穿透距离	双重绝缘层的最小内部缝隙 (内部间隙)	≥ 15.4	μm
CTI	相对漏电起痕指数	DIN EN 60112 (VDE 0303-11) ; IEC 60112	≥ 600	V
	材料组	符合 IEC 60664-1	I	
	过压类别 (符合 IEC 60664-1)	额定市电电压 ≤ 600V _{RMS}	I-III	
		额定市电电压 ≤ 1000V _{RMS}	I-II	
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) ⁽²⁾				
V _{IORM}	最大重复峰值隔离电压	在交流电压下	2120	V _{PK}
V _{IOWM}	最大额定隔离 工作电压	在交流电压下 (正弦波)	1500	V _{RMS}
		在直流电压下	2120	V _{DC}
V _{IOTM}	最大瞬态 隔离电压	V _{TEST} = V _{IOTM} , t = 60s (鉴定测试) , V _{TEST} = 1.2 × V _{IOTM} , t = 1s (100% 生产测试)	7000	V _{PK}
V _{IMP}	最大脉冲电压 ⁽³⁾	在空气中测试, 符合 IEC 62368-1 标准的 1.2/50μs 波形	7700	V _{PK}
V _{IOSM}	最大浪涌 隔离电压 ⁽⁴⁾	在油中进行测试 (鉴定测试) , 符合 IEC 62368-1 的 1.2/50μs 波形	10000	V _{PK}
q _{pd}	视在电荷 ⁽⁵⁾	方法 a, 输入/输出安全测试子组 2 和 3 后, V _{pd(ini)} = V _{IOTM} , t _{ini} = 60s, V _{pd(m)} = 1.2 × V _{IORM} , t _m = 10s	≤ 5	pC
		方法 a, 环境测试子组 1 后, V _{pd(ini)} = V _{IOTM} , t _{ini} = 60s, V _{pd(m)} = 1.6 × V _{IORM} , t _m = 10s	≤ 5	
		方法 b1, 预处理 (类型测试) 和常规测试, V _{pd(ini)} = 1.2 × V _{IOTM} , t _{ini} = 1s, V _{pd(m)} = 1.875 × V _{IORM} , t _m = 1s	≤ 5	
		方法 b2, 常规测试 (100% 生产) ⁽⁷⁾ V _{pd(ini)} = V _{pd(m)} = 1.2 × V _{IOTM} , t _{ini} = t _m = 1s	≤ 5	
C _{IO}	势垒电容, 输入至输出 ⁽⁶⁾	V _{IO} = 0.5V _{PP} (1MHz)	≈1.5	pF
R _{IO}	绝缘电阻, 输入至输出 ⁽⁶⁾	V _{IO} = 500V (T _A = 25°C)	> 10 ¹²	Ω
		V _{IO} = 500V (100°C ≤ T _A ≤ 125°C)	> 10 ¹¹	
		V _{IO} = 500V, T _S = 150°C	> 10 ⁹	
	污染等级		2	
	气候类别		55/125/21	
UL1577				
V _{ISO}	可承受的隔离电压	V _{TEST} = V _{ISO} , t = 60s (鉴定测试) , V _{TEST} = 1.2 × V _{ISO} , t = 1s (100% 生产测试)	5000	V _{RMS}

- (1) 根据应用特定的设备隔离标准应用爬电距离和电气间隙要求。务必使爬电距离和电气间隙一直符合电路板设计的要求, 以确保在印刷电路板 (PCB) 上安装的隔离器焊盘不会缩短这一距离。在某些情况下, PCB 上的爬电距离和电气间隙相等。在 PCB 上插入坡口、肋或两者等技术可帮助提高这些规格。
- (2) 此耦合器仅适用于安全额定值范围内的安全电气绝缘。应借助合适的保护电路来确保符合安全等级。
- (3) 在空气中进行测试, 以确定封装的浪涌抗扰度。
- (4) 在油中进行测试, 以确定隔离栅的固有浪涌抗扰度。
- (5) 视在电荷是局部放电 (pd) 引起的电气放电。
- (6) 将隔离栅每一侧的所有引脚都连在一起, 构成一个双引脚器件。
- (7) 生产中使用方法 b1 或 b2。

6.7 安全相关认证

VDE	UL
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)、 EN IEC 60747-17、 DIN EN IEC 62368-1 (VDE 0868-1)、 EN IEC 62368-1、 IEC 62368-1 条款：5.4.3；5.4.4.4；5.4.9	根据 1577 元件认证和 CSA 元件验收第 5 号计划进行了认证
增强型绝缘	单一绝缘保护
证书编号：待定	文件编号：待定

6.8 安全限值

安全限值⁽¹⁾旨在更大限度地减小在发生输入或输出电路故障时对隔离栅的潜在损害。I/O 发生故障时会导致低电阻接地或连接到电源，如果没有限流电路，则会因为功耗过大而导致芯片过热并损坏隔离栅，甚至可能导致辅助系统出现故障。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
I _{SI}	安全输入电流	R _{θJA} = 86.9°C/W, VDDx = 5.5V, T _J = 150°C, T _A = 25°C, AMC0381D06			250	mA
		R _{θJA} = 86.9°C/W, VDDx = 5.5V, T _J = 150°C, T _A = 25°C, AMC0381D10			240	
		R _{θJA} = 86.9°C/W, VDDx = 5.5V, T _J = 150°C, T _A = 25°C, AMC0381D16			240	
I _{SO}	安全输出电流	R _{θJA} = 86.9°C/W, VDDx = 5.5V, T _J = 150°C, T _A = 25°C			260	mA
P _S	安全输入、输出或总功率	R _{θJA} = 86.9°C/W, T _J = 150°C, T _A = 25°C			1440	mW
T _S	最高安全温度				150	°C

- (1) 最高安全温度 T_S 与器件指定的最大结温 T_J 的值相同。I_S 和 P_S 参数分别表示安全电流和安全功率。请勿超过 I_S 和 P_S 的最大限值。这些限值随着环境温度 T_A 的变化而变化。
- “热性能信息”表中的结至空气热阻 R_{θJA} 是安装在含引线的表面贴装封装的高 K 测试板上的器件的热阻。可使用以下公式来计算各个参数的值：
- T_J = T_A + R_{θJA} × P, 其中, P 为器件上消耗的功率。
- T_{J(max)} = T_S = T_A + R_{θJA} × P_S, 其中, T_{J(max)} 为最大结温。
- P_S = I_S × VDD_{max}, 其中 VDD_{max} 为最大低侧电压。

6.9 电气特性

最小规范值和最大规范值的适用条件如下： $T_A = -40^{\circ}\text{C}$ 至 $+125^{\circ}\text{C}$ ， $V_{DD1} = 3.0\text{V}$ 至 5.5V ， $V_{DD2} = 3.0\text{V}$ 至 5.5V ， $V_{SNSP} = 0\text{V}$ 至 $+1\text{V}$ ， $V_{SNSN} = 0\text{V}$ 。除非另外注明，否则为 $T_A = 25^{\circ}\text{C}$ 、 $V_{DD1} = 5\text{V}$ 且 $V_{DD2} = 3.3\text{V}$ 条件下的典型规范值。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
模拟输入						
R _{IN}	输入电阻	AMC0381D06	8.5	10	11.5	M Ω
		AMC0381D10	10.6	12.5	14.4	
		AMC0381D16	28	33.5	39	
	电阻分压器分压比	V _{HVIN} / V _{SNSP} , AMC0381D06	598	601	604	V/V
		V _{HVIN} / V _{SNSP} , AMC0381D10	996	1001	1006	
		V _{HVIN} / V _{SNSP} , AMC0381D16	1596	1601	1606	
CMTI	共模瞬态抗扰度	SNSP = GND1	150			V/ns
模拟输出						
	标称衰减	(V _{OUTP} - V _{OUTN}) / V _{HVIN} , AMC0381D06		3.328		mV/V
		(V _{OUTP} - V _{OUTN}) / V _{HVIN} , AMC0381D10		1.998		
		(V _{OUTP} - V _{OUTN}) / V _{HVIN} , AMC0381D16		1.249		
V _{CMout}	输出共模电压		1.39	1.44	1.50	V
V _{CLIPout}	削波差分输出电压	V _{OUT} = (V _{OUTP} - V _{OUTN}) ; V _{IN} > V _{Clipping}	-2.52	±2.49	2.52	V
V _{FAILSAFE}	故障安全差分输出电压	VDD1 欠压或 VDD1 缺失	-2.63	-2.57	-2.53	V
R _{OUT}	输出电阻	OUTP 或 OUTN		<0.2		Ω
	输出短路电流	在 OUTP 或 OUTN 上，拉出或灌入， HVIN = GND1，输出短接到 GND 或 VDD2		11		mA
直流精度						
V _{OS}	输入偏移电压	以 SNSP 为基准， T _A = 25°C，HVIN = GND1	-0.8	±0.1	0.8	mV
		以 HVIN 为基准，HVIN = GND1，T _A = 25°C， AMC0381D06	-480	±60	480	
		以 HVIN 为基准，HVIN = GND1，T _A = 25°C， AMC0381D10	-800	±100	800	
		以 HVIN 为基准，HVIN = GND1，T _A = 25°C， AMC0381D16	-1280	±160	1280	
TCV _{OS}	输入失调电压热漂移 ⁽³⁾	以 SNSP 为基准， HVIN = GND1	-0.01	±0.003	0.01	mV/°C
		以 HVIN 为基准，HVIN = GND1，AMC0381D06	-6	±1.8	6	
		以 HVIN 为基准，HVIN = GND1，AMC0381D10	-10	±3	10	
		以 HVIN 为基准，HVIN = GND1，AMC0381D16	-16	±4.8	16	
E _A	衰减误差 ⁽¹⁾	T _A = 25°C	-0.25%	±0.05%	0.25%	
TCE _A	衰减误差温漂 ⁽⁴⁾		-40	±20	40	ppm/°C
	非线性度 ⁽²⁾		-0.025%	±0.01%	0.025%	
	输出噪声	V _{IN} = GND1，BW = 50kHz		200		μVrms
PSRR	电源抑制比 ⁽⁵⁾	VDD1 直流 PSRR，HVIN = GND1， VDD1 为 3V 至 5.5V		-77		dB
		VDD1 交流 PSRR，HVIN = GND1， VDD1 具有 10kHz/100mV 纹波		-49		
		VDD2 直流 PSRR，HVIN = GND1， VDD2 为 3V 至 5.5V		-100		
		VDD2 交流 PSRR，HVIN = GND1， VDD2 具有 10kHz/100mV 纹波		-75		
交流精度						
BW	输出带宽		120	145		kHz

6.9 电气特性 (续)

最小规范值和最大规范值的适用条件如下： $T_A = -40^{\circ}\text{C}$ 至 $+125^{\circ}\text{C}$ ， $V_{DD1} = 3.0\text{V}$ 至 5.5V ， $V_{DD2} = 3.0\text{V}$ 至 5.5V ， $V_{SNSP} = 0\text{V}$ 至 $+1\text{V}$ ， $V_{SNSN} = 0\text{V}$ 。除非另外注明，否则为 $T_A = 25^{\circ}\text{C}$ 、 $V_{DD1} = 5\text{V}$ 且 $V_{DD2} = 3.3\text{V}$ 条件下的典型规范值。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
THD	总谐波失真	$V_{SNSP} = 1V_{PP}$ ， $SNSN = GND1$ ， $f_{IN} = 10\text{kHz}$		-80	-73	dB
SNR	信噪比	$V_{SNSP} = 1V_{PP}$ ， $SNSN = GND1$ ， $f_{IN} = 1\text{kHz}$ ， $BW = 10\text{kHz}$	75	79		dB
SNR	信噪比	$V_{SNSP} = 1V_{PP}$ ， $SNSN = GND1$ ， $f_{IN} = 10\text{kHz}$ ， $BW = 50\text{kHz}$		70		dB
电源						
I_{DD1}	高侧电源电流			4.3	5.6	mA
I_{DD2}	低侧电源电流			6.2	9.7	mA
V_{DD1UV}	高侧欠压检测阈值	VDD1 上升	2.5	2.6	2.7	V
		VDD1 下降	1.9	2.0	2.1	
V_{DD2UV}	低侧欠压检测阈值	VDD2 上升	2.3	2.5	2.7	V
		VDD2 下降	1.9	2.05	2.2	

- 典型值包括一个 Σ 统计变化。
- 根据定义，积分非线性是指距离穿过理想 ADC 传递函数端点的直线之间的最大偏差，以 LSB 的数量表示，或以指定线性满标量程 FSR 的百分比表示。
- 使用框方法计算失调电压误差温漂，如以下公式所述：

$$TCE_O = (\text{value}_{MAX} - \text{value}_{MIN}) / \text{TempRange}$$
- 使用框方法计算衰减误差温漂，如以下公式所述：

$$TCE_A (\text{ppm}) = ((\text{value}_{MAX} - \text{value}_{MIN}) / (\text{value} \times \text{TempRange})) \times 10^6$$
- 此参数以 SNSP 为基准。

6.10 开关特性

在工作环境温度范围内测得（除非另有说明）

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
t_r	输出信号上升时间			2.6		μs
t_f	输出信号下降时间			2.6		μs
	V_{SNSP} 到 V_{OUTx} 的信号延迟 (50% - 10%)	非滤波输出		1.6		μs
	V_{SNSP} 到 V_{OUTx} 的信号延迟 (50% - 50%)	非滤波输出		3.0	3.2	μs
	V_{SNSP} 到 V_{OUTx} 的信号延迟 (50% - 90%)	非滤波输出		4.2		μs
t_{AS}	模拟稳定时间	VDD1 阶跃至 3.0V， $V_{DD2} \geq 3.0\text{V}$ ，到 V_{OUTP} ， V_{OUTN} 有效，0.1% 稳定时间		20	100	μs

6.11 时序图

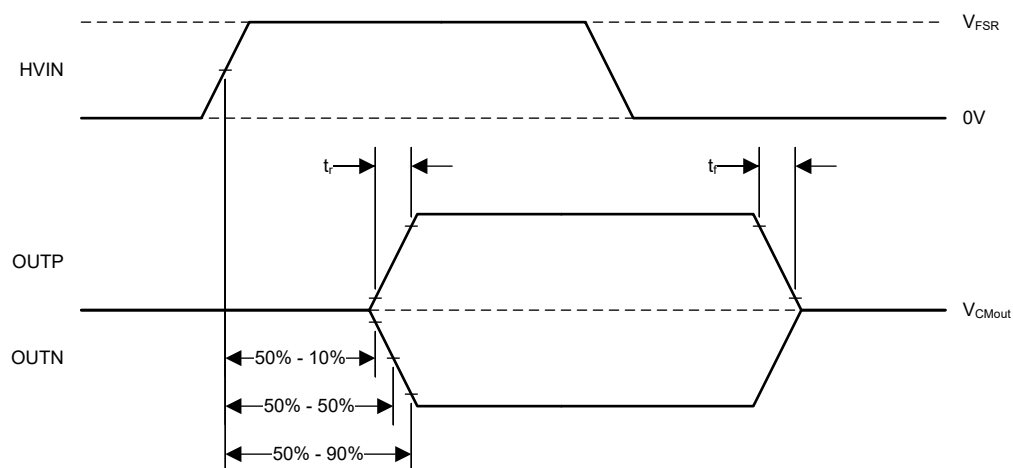


图 6-1. 上升、下降和延迟时间定义

6.12 绝缘特性曲线

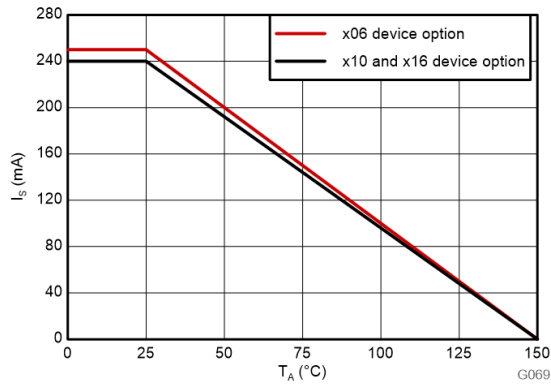


图 6-2. 安全限制电流的热降额曲线 (符合 VDE)

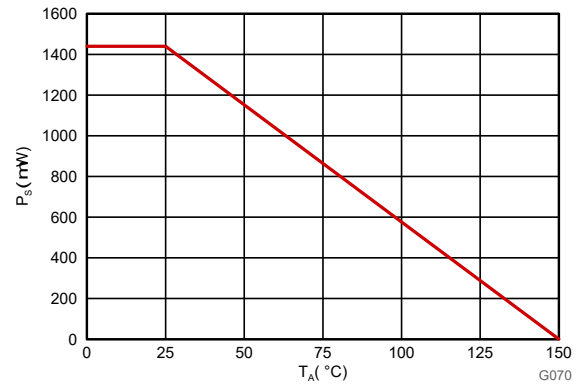
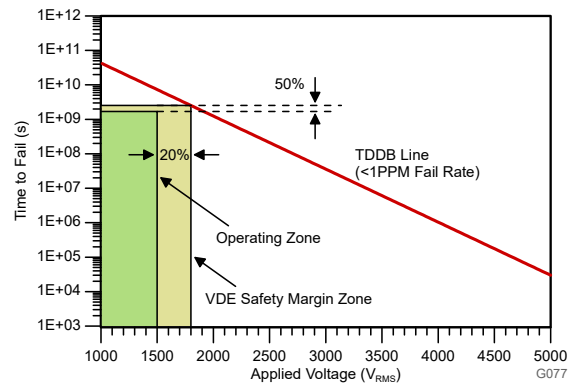


图 6-3. 安全限制功率的热降额曲线 (符合 VDE)



T_A 最高 150°C，应力电压频率 = 60Hz，隔离工作电压 = 1500V_{RMS}，预计工作寿命 ≥ 50 年

图 6-4. 增强型隔离电容器寿命图

6.13 典型特性

条件为：VDD1 = 5V，VDD2 = 3.3V，SNSN = GND1， $f_{IN} = 10\text{kHz}$ （除非另有说明）

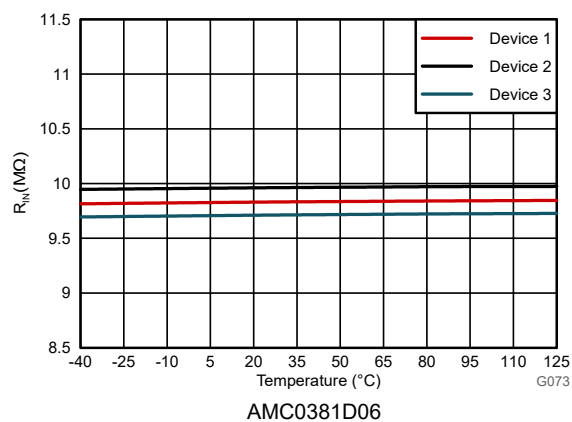


图 6-5. 输入电阻与温度间的关系

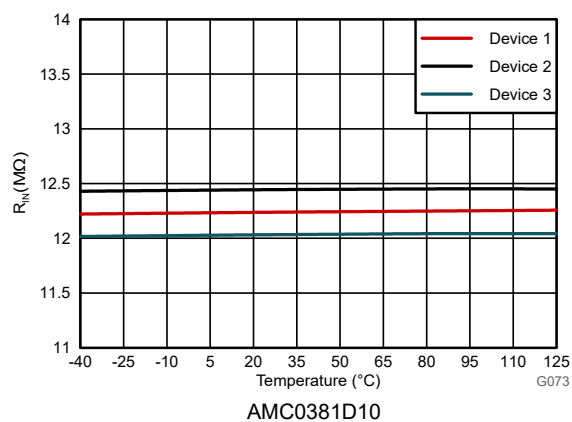


图 6-6. 输入电阻与温度间的关系

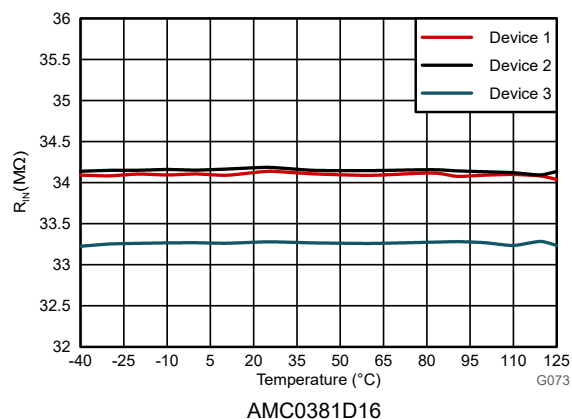


图 6-7. 输入电阻与温度间的关系

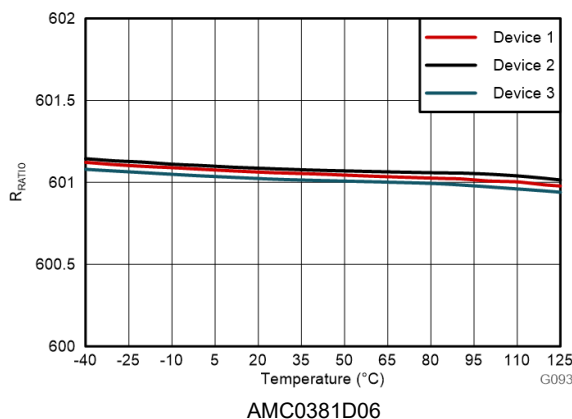


图 6-8. 分压器分压比与温度间的关系

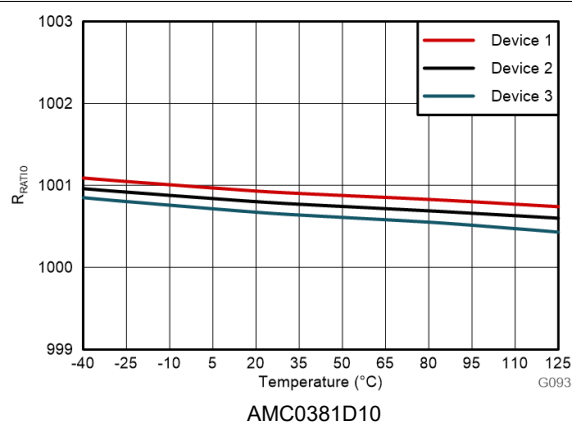


图 6-9. 分压器分压比与温度间的关系

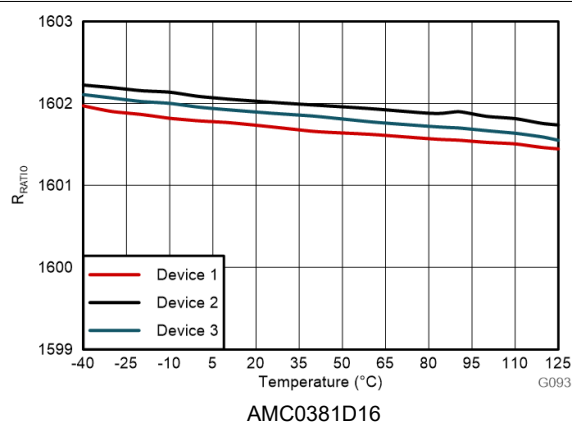


图 6-10. 分压器分压比与温度间的关系

6.13 典型特性 (续)

条件为: $V_{DD1} = 5V$, $V_{DD2} = 3.3V$, $SNSN = GND1$, $f_{IN} = 10kHz$ (除非另有说明)

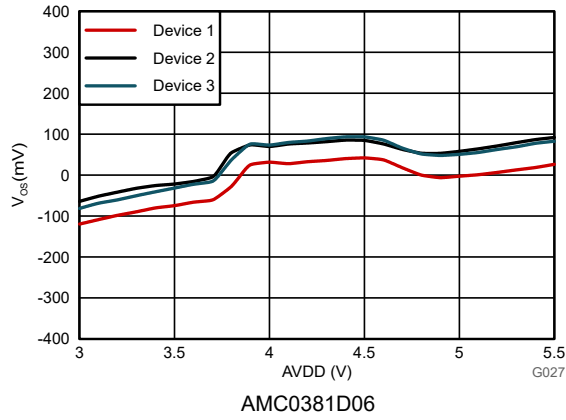


图 6-11. 输入失调电压与高侧电源电压间的关系

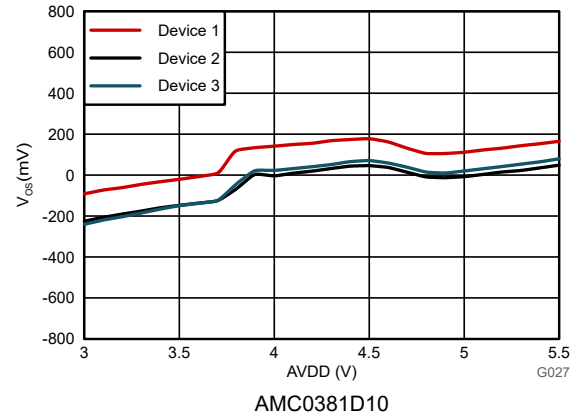


图 6-12. 输入失调电压与高侧电源电压间的关系

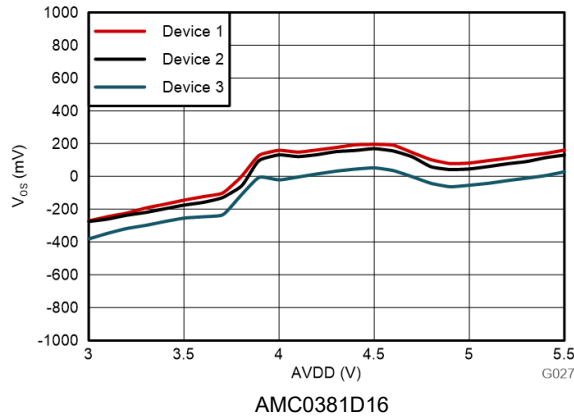


图 6-13. 输入失调电压与高侧电源电压间的关系

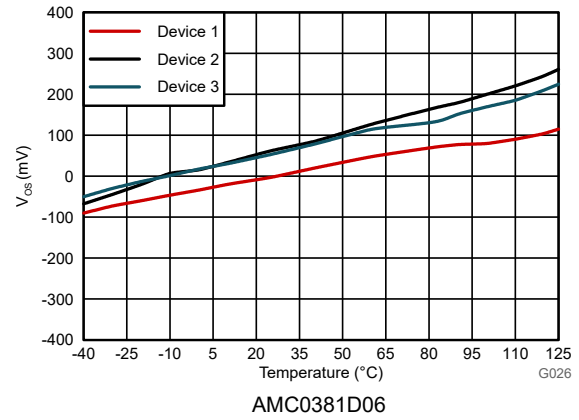


图 6-14. 输入失调电压与温度间的关系

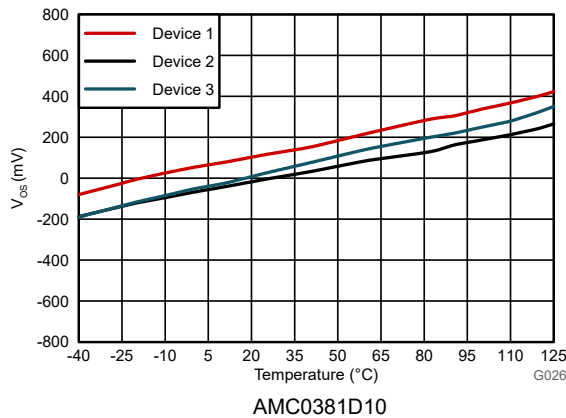


图 6-15. 输入失调电压与温度间的关系

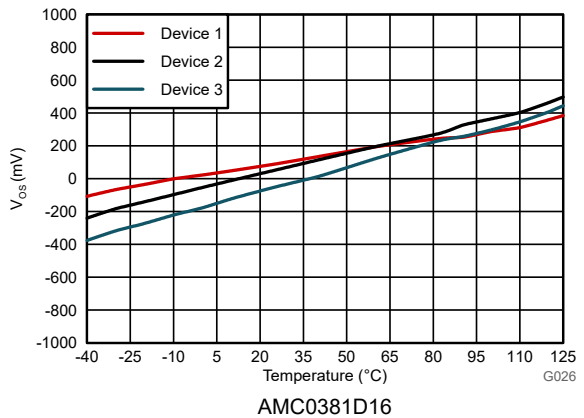


图 6-16. 输入失调电压与温度间的关系

6.13 典型特性 (续)

条件为: $V_{DD1} = 5V$, $V_{DD2} = 3.3V$, $SNSN = GND1$, $f_{IN} = 10kHz$ (除非另有说明)

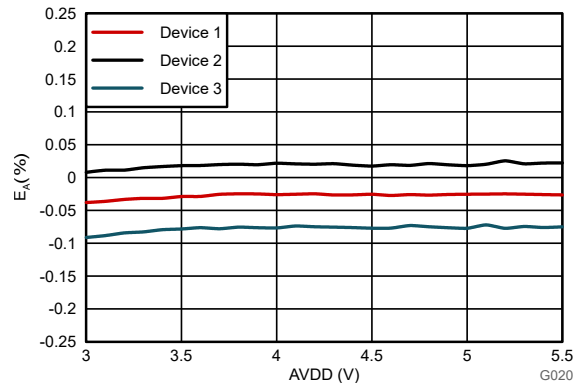


图 6-17. 衰减误差与高侧电源电压间的关系

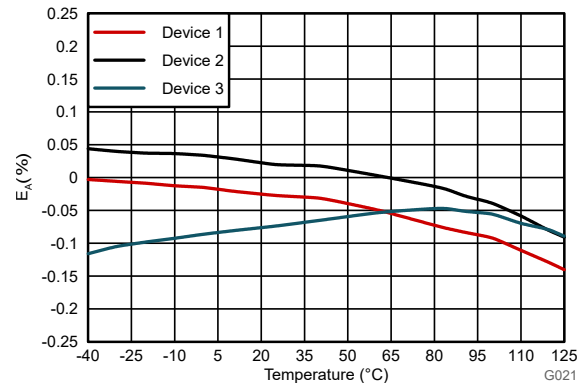


图 6-18. 衰减误差与温度间的关系

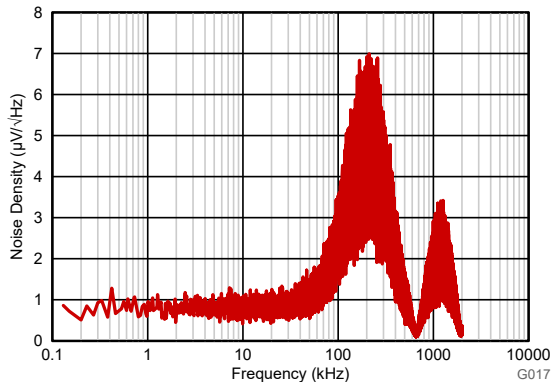


图 6-19. 输入基准电压噪声密度与频率间的关系

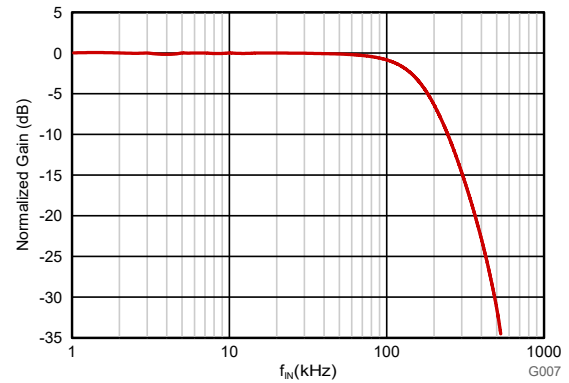


图 6-20. 归一化增益与输入频率间的关系

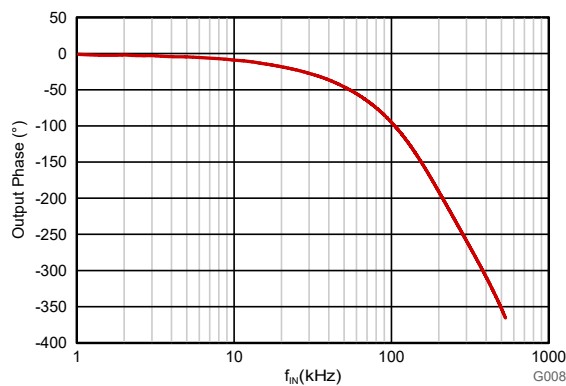


图 6-21. 输出相位与输入频率间的关系

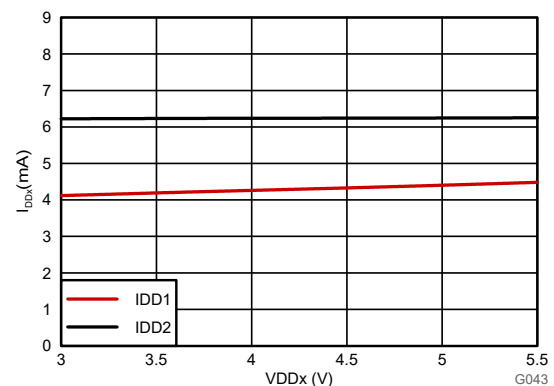


图 6-22. 电源电流与电源电压间的关系

6.13 典型特性 (续)

条件为：VDD1 = 5V，VDD2 = 3.3V，SNSN = GND1， $f_{IN} = 10\text{kHz}$ （除非另有说明）

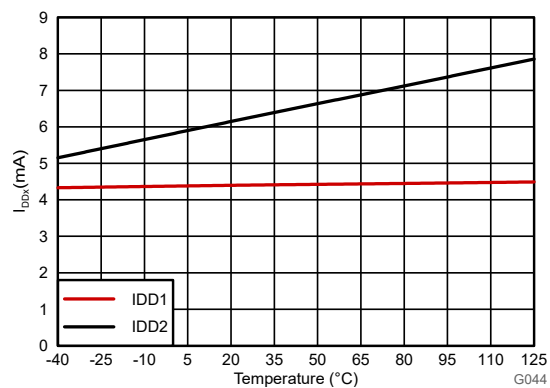


图 6-23. 电源电流与温度间的关系

7 详细说明

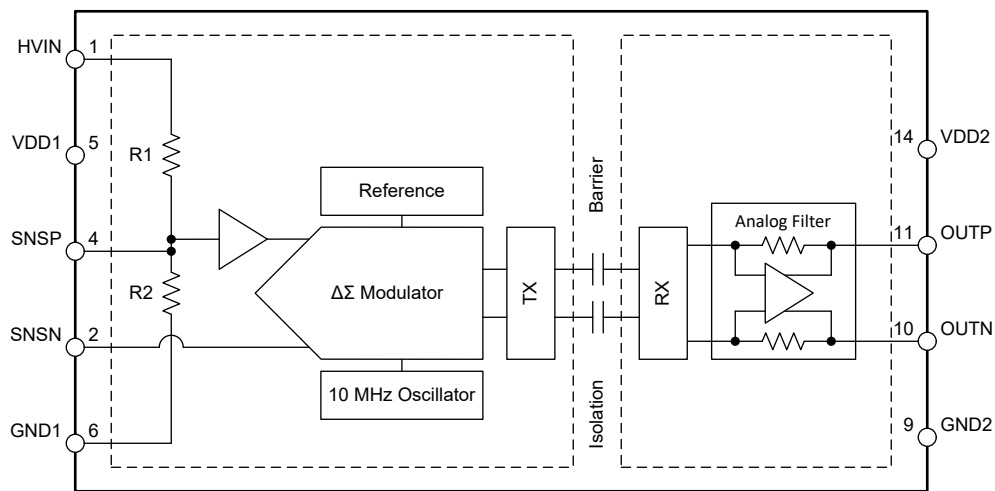
7.1 概述

AMC0381D 是一款精密的电隔离放大器，具有 高压直流、高阻抗输入和固定增益差动输出。该器件的输入级驱动一个二阶 Δ - Σ 调制器。调制器将模拟输入信号转换为数字比特流，该比特流通过用于隔离高侧和低侧的隔离栅进行传输。

在低侧，接收到的位流由四阶模拟滤波器处理，该滤波器在 OUTP 和 OUTN 引脚输出差分信号。这个差分输出信号与输入信号成正比。

基于 SiO_2 的电容隔离栅支持高水平的磁场抗扰度，如 [ISO72x 数字隔离器磁场抗扰度 应用手册](#) 中所述。AMC0381D 中使用的数字调制跨过隔离栅传输数据。这种调制方案加上隔离栅的特性，可确保实现高可靠性，并具有高共模瞬态抗扰度。

7.2 功能方框图



7.3 特性说明

7.3.1 模拟输入

AMC0381D 输入端的电阻分压器将施加到 HVIN 引脚的电压降低至 1V 线性满量程电平。此信号在 SNSP 引脚上提供，该引脚也是模拟信号链的输入端。

SNSP 引脚的高阻抗输入缓冲器为二阶开关电容器前馈 Δ Σ 调制器供电。调制器将模拟信号转换为通过隔离栅传输的比特流，如 [隔离通道信号传输](#) 部分所述。

7.3.2 隔离通道信号传输

如图 7-1 中所示，AMC0381D 使用开关键控 (OOK) 调制方案跨过基于 SiO_2 的隔离栅传输调制器输出位流。发送驱动器 (TX) 如 功能方框图 中所示。TX 跨过隔离栅发送一个内部生成的高频载波来表示数字一。而 TX 不发送信号则表示数字零。AMC0381D 内使用的载波标称频率为 480MHz。

隔离栅另一侧的接收器 (RX) 恢复和解调信号，并将输入提供给模拟滤波器。AMC0381D 传输通道经过优化，可实现超高共模瞬态抗扰度 (CMTI) 和超低辐射发射。高频载波和 RX/TX 缓冲器开关会导致这些发射。

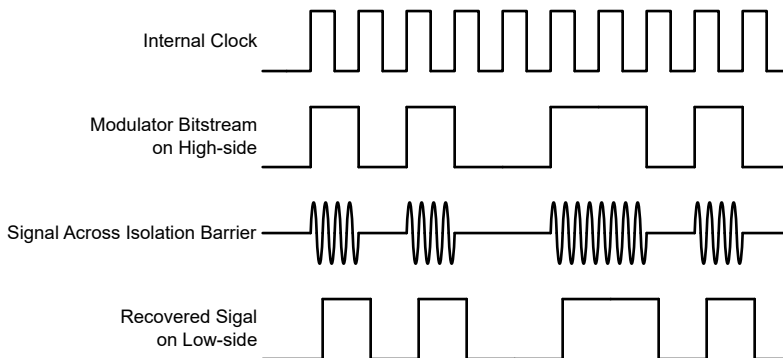


图 7-1. 基于 OOK 的调制方案

7.3.3 模拟输出

AMC0381D 在 OUTP 和 OUTN 引脚上提供与输入电压成正比的差分模拟输出电压。对于 $V_{FSR, MIN}$ 至 $V_{FSR, MAX}$ 范围内的输入电压，该器件具有线性响应，输出电压等于：

$$(V_{OUTP} - V_{OUTN}) = 2 \times V_{IN} = 2 \times (V_{HVIN} / [\text{电阻分压器分压比}] - V_{SNSN}) \quad (1)$$

在零输入端，两个引脚输出相同的共模输出电压 V_{CMout} ，如 [电气特性](#) 表中所指定。对于大于 $|V_{FSR}|$ 但小于 $|V_{Clipping}|$ 的绝对输入电压，差分输出电压的幅度会继续增加，但线性性能会降低。输出在 $V_{CLIPout}$ 的差分输出电压处饱和，如图 7-2 所示（如果输入电压超过 $V_{Clipping}$ 值）。

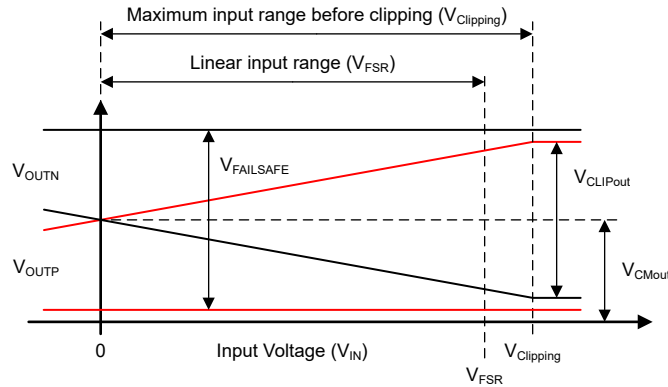


图 7-2. AMC0381D 的输入到输出传递曲线

AMC0381D 输出提供失效防护功能，可简化系统级诊断。图 7-2 展示了失效防护模式中的行为，其中 AMC0381D 输出在正常工作条件下不会出现的负差分输出电压。在以下情况下，失效防护输出激活：

- 当 AMC0381D 器件的高侧电源 VDD1 缺失时
- 当高侧电源 VDD1 降至低于欠压阈值 $VDD1_{UV}$ 时

使用最大 $V_{FAILSAFE}$ 电压（在 [电气特性](#) 表中指定）作为系统级失效防护检测的基准值。

7.4 器件功能模式

AMC0381D 在以下其中一种状态下运行：

- 关断状态：低侧电源 (VDD2) 低于 $VDD2_{UV}$ 阈值。器件无响应。OUTP 和 OUTN 处于高阻态状态。在内部，OUTP 和 OUTN 由 ESD 保护二极管钳位到 VDD2 和 GND2。
- 高侧电源缺失：器件的低侧 (VDD2) 已供电处于建议运行条件下。高侧电源 (VDD1) 低于 $VDD1_{UV}$ 阈值。器件输出 $V_{FAILSAFE}$ 电压。
- 模拟输入超范围（正满标量程输入）：VDD1 和 VDD2 处于建议运行条件下，但模拟输入电压 V_{IN} 高于最大削波电压 $V_{Clipping, MAX}$ 。器件输出正 $V_{CLIPout}$ 。
- 模拟输入欠范围（负满标量程输入）：VDD1 和 VDD2 处于建议运行条件下，但模拟输入电压 V_{IN} 低于最小削波电压 $V_{Clipping, MIN}$ 。器件输出负 $V_{CLIPout}$ 。
- 正常运行：VDD1、VDD2 和 V_{IN} 处于建议运行条件内。器件输出与输入电压成正比的差分电压。

表 7-1 列出了运行模式。

表 7-1. 器件运行模式

运行条件	VDD1	VDD2	V_{IN}	器件响应
关闭	无关	$VDD2 < VDD2_{UV}$	无关	OUTP 和 OUTN 处于高阻态状态。在内部，OUTP 和 OUTN 由 ESD 保护二极管钳位到 VDD2 和 GND2。
高侧电源缺失	$VDD1 < VDD1_{UV}$	有效 ⁽¹⁾	无关	器件输出 $V_{FAILSAFE}$ 电压。
输入超范围	有效 ⁽¹⁾	有效 ⁽¹⁾	$V_{IN} > V_{Clipping, MAX}$	器件输出正 $V_{CLIPout}$ 。
输入欠范围	有效 ⁽¹⁾	有效 ⁽¹⁾	$V_{IN} < V_{Clipping, MIN}$	器件输出负 $V_{CLIPout}$ 。
正常运行	有效 ⁽¹⁾	有效 ⁽¹⁾	有效 ⁽¹⁾	器件输出与输入电压成正比的差分电压。

(1) 有效表示在建议运行条件内运行。

8 应用和实施

备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 元件规格，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户负责确定元件是否适合其用途，以及验证和测试其设计实现以确认系统功能。

8.1 应用信息

工业电源系统（例如电机驱动器）分为两个或更多彼此电隔离的电压域。例如，高压域包括用于驱动电机的交流电网、直流链路和功率级。低压域包括系统控制器和人机界面。出于安全原因，控制器测量直流链路电压值，同时保持与高压侧的电隔离。凭借高阻抗输入和电隔离输出，AMC0381D 可实现此测量。

8.2 典型应用

下图展示了三相电机驱动交流逆变器的简化原理图。AMC0381D 用于直流链路电压检测。在电源域中，AMC0381D 直接连接在 DC(+) 和 DC(-) 之间。低侧栅极驱动器电源被调节至 5V 电平，为 AMC0381D 的高压侧供电。在隔离栅另一侧的信号域中，AMC0381D 输出一个与直流链路电压成正比的电压。

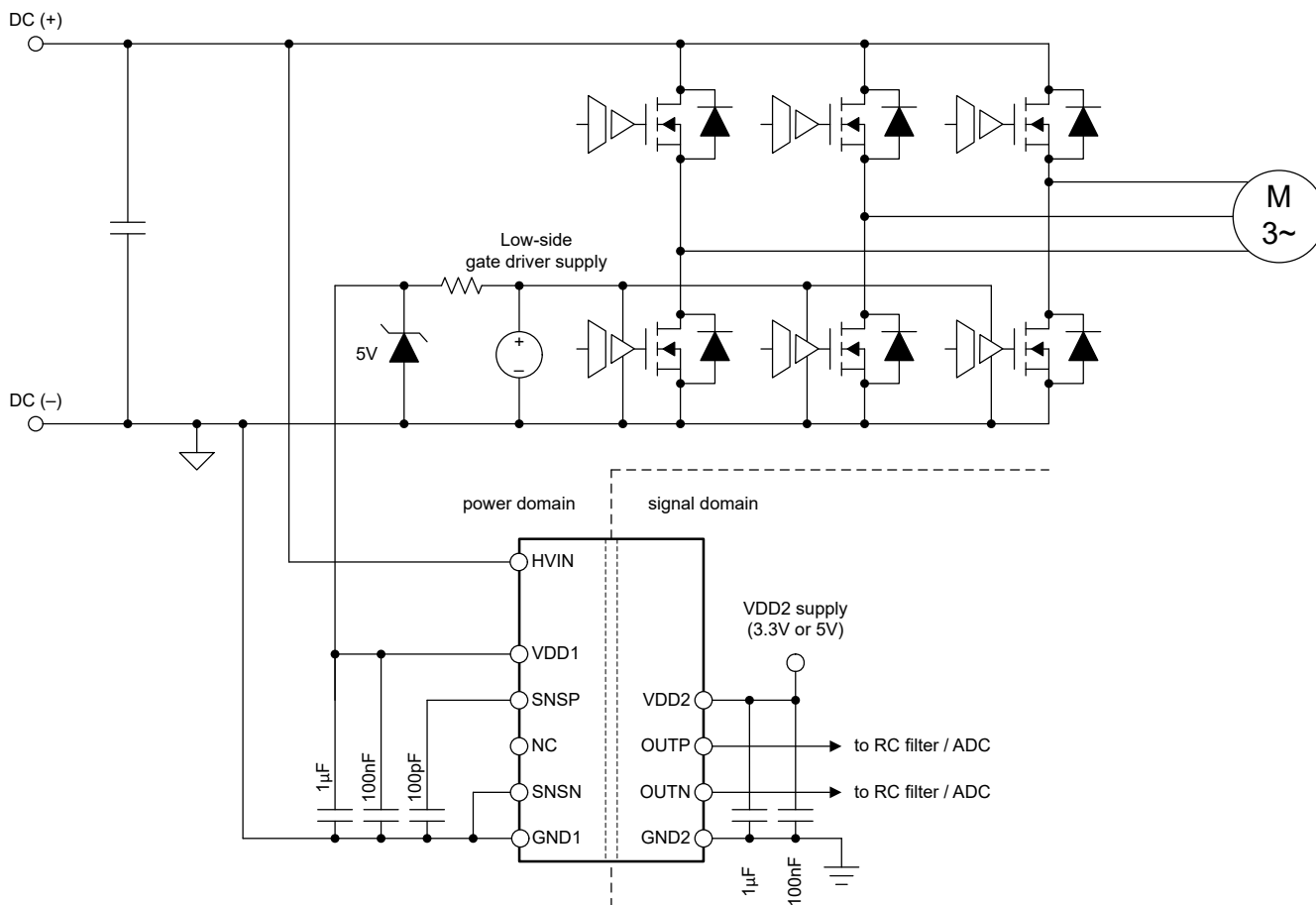


图 8-1. 在典型应用中使用 AMC0381D

8.2.1 设计要求

表 8-1 列出了此典型应用的参数。

表 8-1. 设计要求

参数	值
直流链路电压	450V (最大值)
高侧电源电压	5V
低侧电源电压	3.3V

8.2.2 详细设计过程

在此设计示例中，最大直流链路电压为 450V。为获得出色的测量分辨率，请从 AMC0381D 系列中选择器件，该系列具有与峰值输入电压最匹配的线性输入范围。AMC0381D06 支持 600V 的线性输入范围，非常适合该应用。将 HVIN 直接连接到 DC (+)，将 GND1 连接到 DC (-)；请参阅 [典型应用](#) 部分的图表。

8.2.2.1 输入滤波器设计

将一个滤波电容器连接到 SNSP 引脚可提高信号路径的信噪比性能。当频率接近 $\Delta \Sigma$ 调制器采样频率 (通常为 10MHz) 时，调制器会将输入噪声折返至低频范围内。使用 RC 滤波器的目的是将高频噪声衰减至低于测量所需的噪声水平。在实践中，比调制器频率低两个数量级的截止频率可以产生良好的效果。

输入滤波器的截止频率由内部检测电阻器 R2 和外部滤波器电容器 C5 决定。截止频率的计算结果为 $1 / (2 \times \pi \times R2 \times C5)$ 。

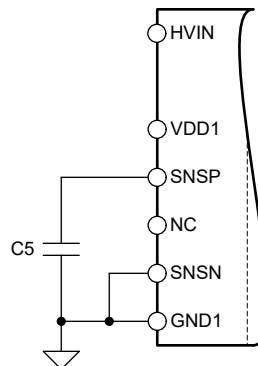


图 8-2. 输入滤波器

8.2.2.2 差分至单端输出转换

许多系统使用具有单端输入的 ADC，无法直接连接到 AMC0381D 的差分输出。图 8-3 展示了一个将差分输出信号转换为 ADC 前面的单端信号的电路。当 $R1 = R3$ 且 $R2 = R4$ 时，输出电压等于 $(R2/R1) \times (V_{OUTP} - V_{OUTN}) + V_{REF}$ 。当 $C1 = C2$ 时，滤波器的带宽变为 $1/(2 \times \pi \times C1 \times R1)$ 。根据系统的带宽要求配置该滤波器级的带宽。为了获得出色线性度，请使用具有低电压系数的电容器（例如 NP0 型电容器）。对于大多数应用， $R1 = R2 = R3 = R4 = 3.3k\Omega$ 和 $C1 = C2 = 330pF$ 可产生良好的性能。

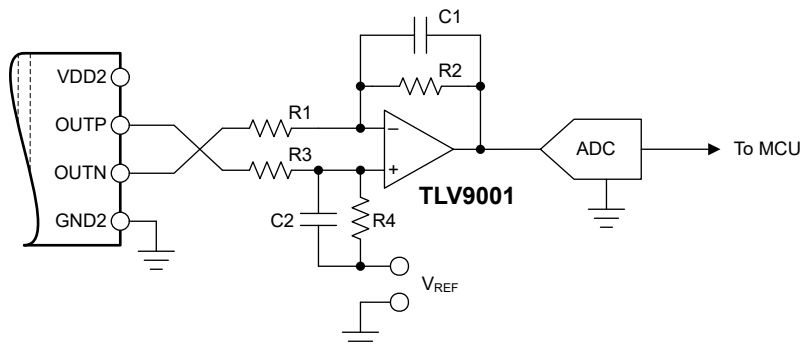


图 8-3. 将 AMC0381D 输出连接到单端输入 ADC

以下参考指南进一步介绍了设计 SAR ADC 滤波级和驱动级的一般过程。这两份参考指南均可从 www.ti.com 下载

- [经优化可实现更低失真和噪声的 18 位 1MSPS 数据采集块 \(DAQ\) 参考指南](#)
- [经优化可实现更低功耗的 18 位数据采集块 \(DAQ\) 参考指南](#)

8.2.3 应用曲线

图 8-4 显示了 AMC0381D 的典型满量程阶跃响应。

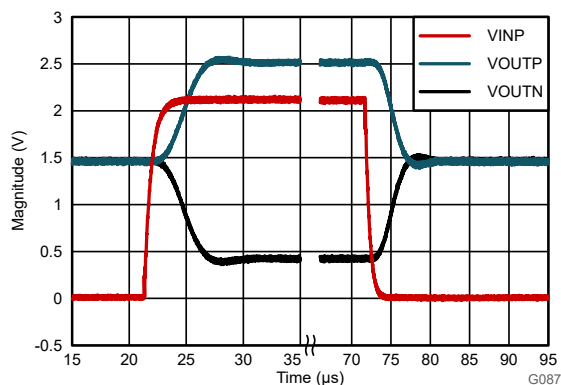


图 8-4. AMC0381D 的阶跃响应

8.3 最佳设计实践

避免 HVIN 和 SNSP 引脚之间出现任何形式的漏电流。漏电流可能会引入显著的测量误差。请参阅 [布局示例](#) 了解布局建议。

8.4 电源相关建议

在典型应用中，AMC0381D 的高侧电源 (VDD1) 由隔离式直流/直流转换器从低侧电源 (VDD2) 生成。一种低成本方案基于推挽式驱动器 [SN6501](#) 和支持所需隔离电压额定值的变压器。

AMC0381D 无需任何特定的上电时序。高侧电源 (VDD1) 通过与低 ESR、 $1\mu\text{F}$ 电容器 (C2) 并联的低 ESR、 100nF 电容器 (C1) 进行去耦。低侧电源 (VDD2) 同样通过与低 ESR、 $1\mu\text{F}$ 电容器 (C4) 并联的低 ESR、 100nF 电容器 (C3) 进行去耦。将所有四个电容器 (C1、C2、C3 和 C4) 尽可能靠近器件放置。图 8-5 展示了 AMC0381D 的去耦图。

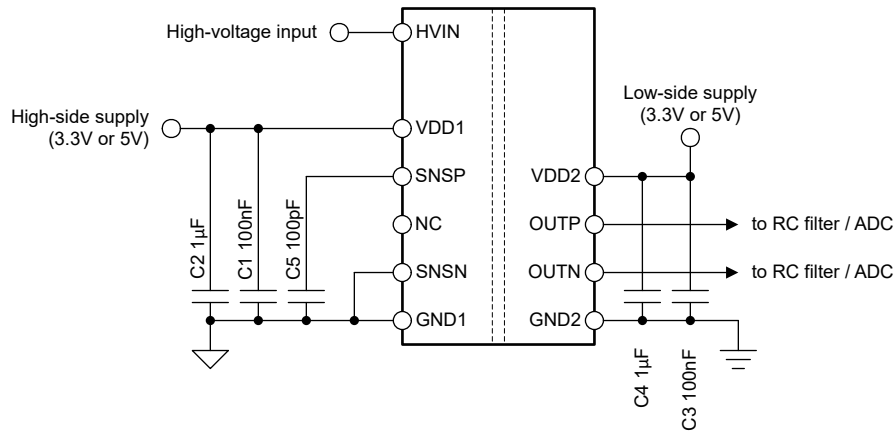


图 8-5. AMC0381D 去耦

在应用中出现的适用直流偏置条件下，验证电容器能提供足够有效的电容。在实际条件下，通常仅使用多层陶瓷电容器 (MLCC) 标称电容的一小部分。在选择这些电容器时，应考虑到这个因素。此问题在低厚度电容器中尤为严重，在该类电容器中，电容器越薄，电介质电场强度越大。知名电容器制造商提供了电容与直流偏置关系曲线，这大大简化了元件的选型。

8.5 布局

8.5.1 布局指南

布局示例 部分详细说明了布局建议，其中去耦电容器的放置尤为关键（尽可能靠近 AMC0381D 电源引脚）。这个示例还说明了器件所需的其它元件的放置方式。

8.5.2 布局示例

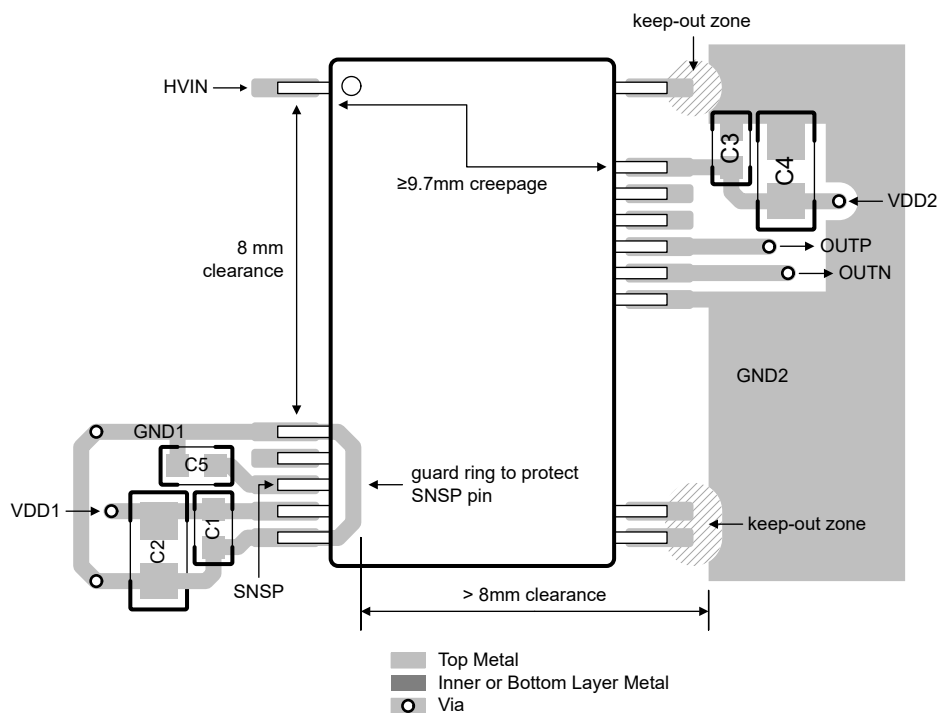


图 8-6. AMC0381D 的建议布局

9 器件和文档支持

9.1 文档支持

9.1.1 相关文档

请参阅以下相关文档：

- 德州仪器 (TI)，[隔离相关术语 应用手册](#)
- 德州仪器 (TI)，[半导体和 IC 封装热指标 应用手册](#)
- 德州仪器 (TI)，[ISO72x 数字隔离器磁场抗扰度 应用手册](#)
- 德州仪器 (TI)，[隔离放大器电压检测 Excel 计算器 设计工具](#)

9.2 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 [ti.com](#) 上的器件产品文件夹。点击 [通知](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

9.3 支持资源

[TI E2E™ 中文支持论坛](#) 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的[使用条款](#)。

9.4 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

9.5 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

9.6 术语表

[TI 术语表](#) 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

10 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from OCTOBER 16, 2025 to NOVEMBER 15, 2025 (from Revision A (October 2025) to Revision B (November 2025))	Page
• 将 V_{IORM} 从 1410V 更改为 2120V.....	8
• 将 V_{IOWM} 从 1000V _{RMS} / 1410V _{PK} 更改为 1500V _{RMS} / 2120V _{PK}	8
• 更新了 应用和实施部分	22

Changes from SEPTEMBER 22, 2025 to OCTOBER 15, 2025 (from Revision A (September 2025) to Revision * (October 2025))	Page
• 将 AMC0381D06 和 AMC0381D10 器件状态从 产品预发布 更改为 量产数据	3
• 添加了 AMC0381D06 和 AMC0381D10 器件的 典型特性	14

11 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 销售条款](#)、[TI 通用质量指南](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2025，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月